

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРО- И ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ

Пономарев С. А., Рогило Д. И., Петров А. С., Щеглов Д. В., Латышев А. В. Кинетика травления поверхности Si(111) молекулярным пучком селена	4
Варавин В. С., Дворецкий С. А., Михайлов Н. Н., Ремесник В. Г., Сабина И. В., Сидоров Ю. Г., Швец В. А., Якушев М. В., Латышев А. В. Современное состояние и перспективы молекулярно-лучевой эпитаксии CdHgTe	12
Дерябин А. С., Долбак А. Е., Есин М. Ю., Машанов В. И., Никифоров А. И., Пчеляков О. П., Соколов Л. В., Тимофеев В. А. Молекулярно-лучевая эпитаксия напряжённых наногетероструктур на основе Si, Ge, Sn	27
Журавлев К. С., Протасов Д. Ю., Бакаров А. К., Торопов А. И., Гуляев Д. В., Лапин В. Г., Лукашин В. М., Пашковский А. Б. Новый тип гетероструктур для мощных рНЕМТ-транзисторов	36
Малин Т. В., Милахин Д. С., Мансуров В. Г., Кожухов А. С., Протасов Д. Ю., Лошкарёв И. Д., Журавлев К. С. Рост нитридных гетероэпитаксиальных транзисторных структур: от эпитаксии буферных слоёв до пассивации поверхности	44
Сидоров Г. Ю., Горшков Д. В., Сидоров Ю. Г., Сабина И. В., Варавин В. С. Влияние обработки поверхности на плотность заряда на границе раздела эпитаксиальных плёнок GdHgTe и Al ₂ O ₃ , выращенного методом атомно-слоевого осаждения	52
Емельянов Е. А., Петрушков М. О., Путятю М. А., Лошкарёв И. Д., Васев А. В., Семягин Б. Р., Преображенский В. В. Молекулярно-лучевая эпитаксия твёрдого раствора InAsSb: влияние скорости роста на состав эпитаксиальных слоёв	58

НАНОТЕХНОЛОГИИ В ОПТИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ

Милёхин А. Г., Дуда Т. А., Родякина Е. Е., Аникин К. В., Кузнецов С. А., Milekhin I. A., Zahn D. R. T., Латышев А. В. Плазмон-усиленная колебательная спектроскопия полупроводниковых нанокристаллов	64
Рябцев И. И., Митянин К. Ю., Бетеров И. И., Третьяков Д. Б., Энтин В. М., Яшина Е. А., Альянова Н. В., Неизвестный И. Г. Квантовые вычисления на основе одиночных ультрахолодных атомов в оптических ловушках	72
Гайслер В. А., Дерезов И. А., Гайслер А. В., Дмитриев Д. В., Торопов А. И., Качанова М. М., Живодков Ю. А., Кожухов А. С., Щеглов Д. В., Латышев А. В. Сверхминиатюрные излучатели на основе полупроводниковых наноструктур	81
Рубцова Н. Н., Борисов Г. М., Ковалев А. А., Ледовских Д. В., Преображенский В. В., Путятю М. А., Семягин Б. Р., Кузнецов С. А., Пивцов В. С. Свойства квантовых ям и их применение в фемтосекундных лазерах ближнего ИК-диапазона с субгигагерцовой частотой следования импульсов	91
Щеглов Д. В., Ситников С. В., Федина Л. И., Рогило Д. И., Кожухов А. С., Латышев А. В. От самоорганизации монокристаллических ступеней на поверхности кремния к субнанометровой метрологии	98
Боев М. В., Брагинский Л. С., Ковалёв В. М., Магарилл Л. И., Махмудиан М. М., Энтин М. В. Транспортные свойства двумерных топологических изоляторов и экситонных конденсатов	112

Тарасов А. С., Голяшов В. А., Ищенко Д. В., Ахундов И. О., Климов А. Э., Эпов В. С., Кавеев А. К., Супрун С. П., Шерстякова В. Н., Терещенко О. Е. Эффект поля и спин-вентильный эффект в кристаллическом топологическом изоляторе PbSnTe	121
--	-----